

TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD (Charge Coupled Device)

TCD2918BFG

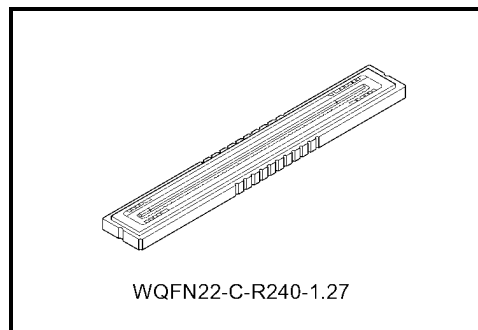
CCD リニアイメージセンサ CCD (charge coupled device)

TCD2918BFG

TCD2918BFG は、感光部に高感度・低暗時出力の pn フォトダイオードを採用した 10680 画素 × 3 ライン出力の縮小型高感度カラーリニアイメージセンサです。

カラーPPC 用センサおよびカラーイメージスキャナ用センサとして使用すると、A4 サイズの原稿を 48 本/mm の密度で読み取ることができます。

駆動パルスは 3.3 V、電源電圧は 10 V 単一電源です。



特 長

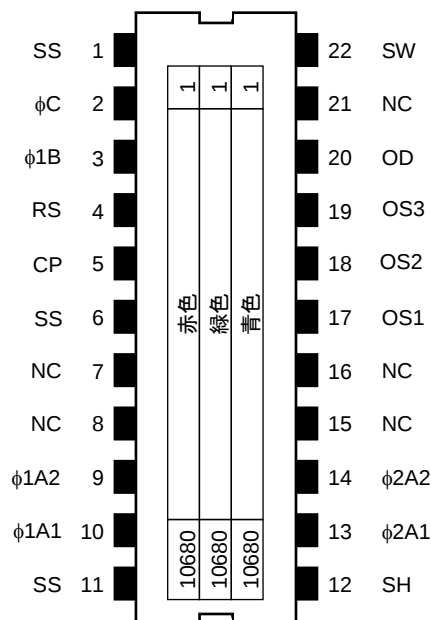
- 有効画素数 : 10680 画素 × 3 ライン
- 画素サイズ : 2.625 μm × 8.4 μm (2.625 μm ピッチ)
- 感光部 : 高感度・低暗時出力の pn フォトダイオード
- 駆動パルス : 3.3 V
- 電源電圧 : 10 V 単一電源
- ライン間距離 : 31.5 μm (12 ライン) 赤色画素 – 緑色画素、緑色画素 – 青色画素
- 付加機能 : クランプ回路内蔵
- パッケージ : 22 ピン CLCC
- カラーフィルタ : 赤色、緑色、青色の原色系フィルタ

絶対最大定格 (注 1)

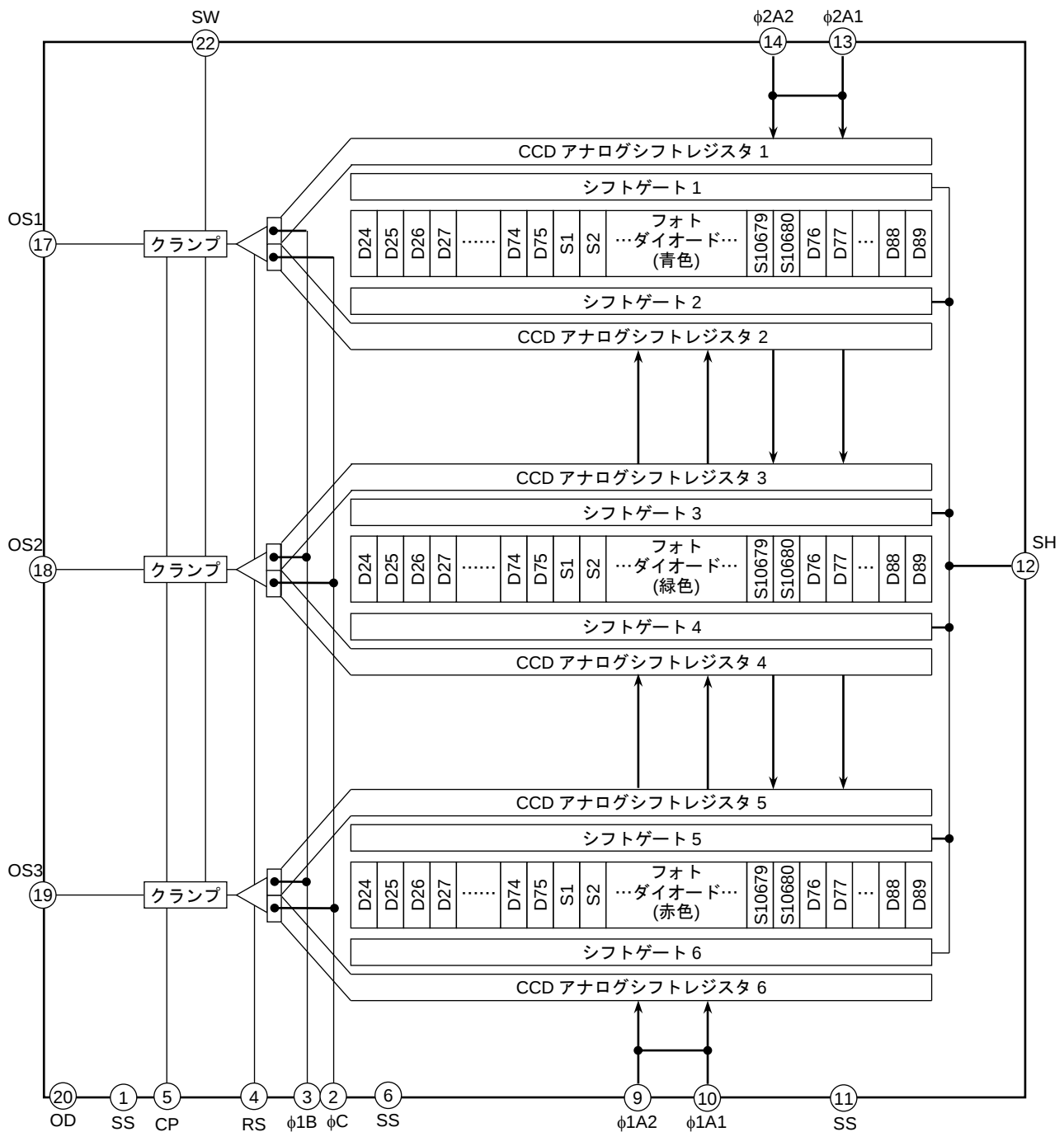
項 目	記 号	定 格	単位
クロックパルス電圧	V_{ϕ}	-0.3 ~ +8.0	V
シフトパルス電圧	V_{SH}		
リセットパルス電圧	V_{RS}		
クランプパルス電圧	V_{CP}		
スイッチパルス電圧	V_{SW}		
電源電圧	V_{OD}	-0.3 ~ +13.5	V
動作温度	T_{opr}	0 ~ 60	°C
保存温度	T_{stg}	-25 ~ +85	°C

注 1: 絶対最大定格電圧は、すべて SS (グラウンド) を基準とします。半導体デバイスの絶対最大定格は、ほんの一瞬でも超えてはならない限界値です。いずれかの値を超えた場合、デバイスの電気特性、信頼性、寿命を保証することはできません。また、定格値を超えると破壊、破損および劣化の原因となります。どのような状況においても絶対最大定格を超えないよう設計することが必要です。

ピン接続図(上面図)



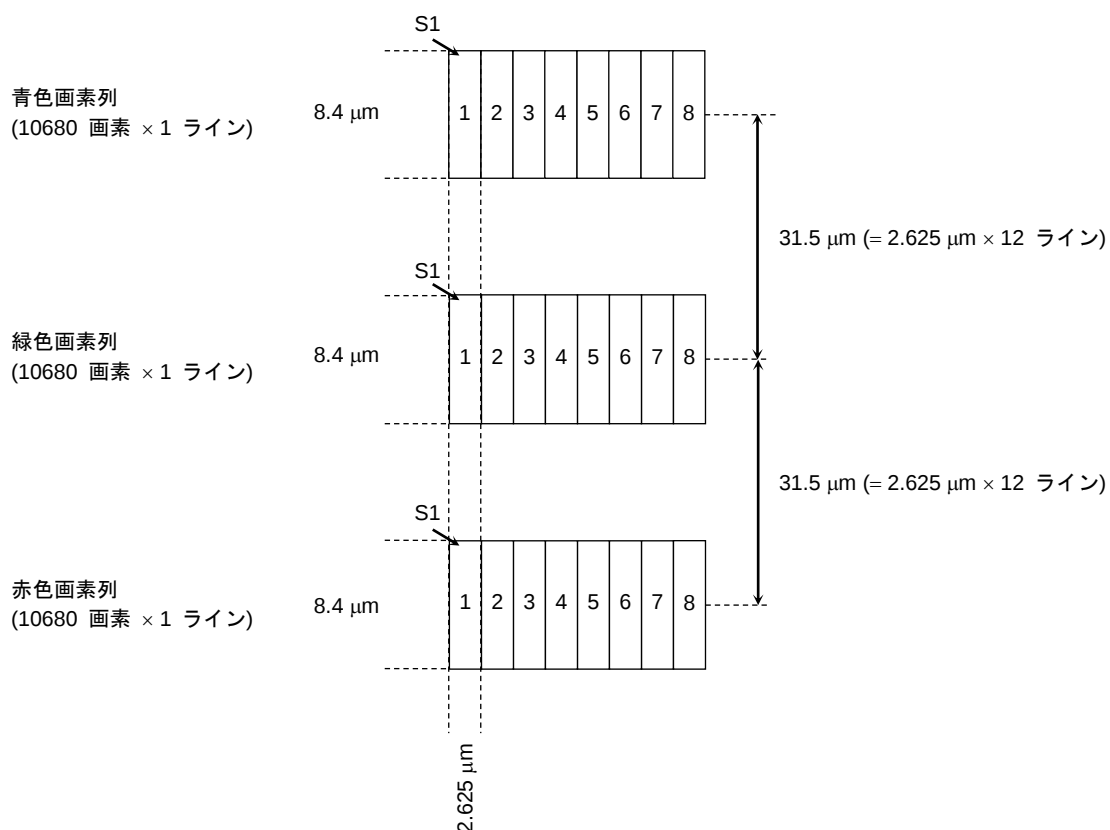
デバイス回路図



ピン名称

ピン番号	記号	名 称	ピン番号	記号	名 称
1	SS	グラウンド	22	SW	スイッチゲート(アンプゲイン切り替え)
2	ϕC	最終段転送クロック C	21	NC	無接続
3	$\phi 1B$	最終段転送クロック B(第 1 相)	20	OD	電源
4	RS	リセットゲート	19	OS3	信号出力 3 (赤色)
5	CP	クランプゲート	18	OS2	信号出力 2 (緑色)
6	SS	グラウンド	17	OS1	信号出力 1 (青色)
7	NC	無接続	16	NC	無接続
8	NC	無接続	15	NC	無接続
9	$\phi 1A2$	転送クロック A2 (第 1 相)	14	$\phi 2A2$	転送クロック A2 (第 2 相)
10	$\phi 1A1$	転送クロック A1 (第 1 相)	13	$\phi 2A1$	転送クロック A1 (第 2 相)
11	SS	グラウンド	12	SH	シフトゲート

第一番目の画素(S1) の配置



電気・光学的特性 (1200 dpi, ハイ・ゲインモード)

$T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{OD} = 10\text{ V}$, $V_{\phi} = V_{SH} = V_{RS} = V_{CP} = 3.3\text{ V}$ (パルス), $f_{\phi} = 2.5\text{ MHz}$, $f_{RS} = 5.0\text{ MHz}$,
 $t_{INT} = 11\text{ ms}$, 光源 = A 光源 + CM500S ($t = 1.0\text{ mm}$)

項 目		記 号	最小	標準	最大	単位	備考
感度	赤色	R _R	13.2	18.9	24.6	V/(lx·s)	(注 2)
	緑色	R _G	14.2	20.3	26.4		
	青色	R _B	7.7	11.1	14.5		
感度不均一性		PRNU (1)	—	10	20	%	(注 3)
		PRNU (3)	—	3	12	mV	(注 4)
レジスタインバランス		RI	—	1	—	%	(注 5)
飽和出力電圧		V _{SAT}	2.0	2.5	—	V	(注 6)
飽和露光量		SE	0.07	0.12	—	lx·s	(注 7)
暗時出力電圧		V _{DRK}	—	0.3	2.0	mV	(注 8)
暗時出力不均一性		DSNU	—	2.0	10.0	mV	
直流消費電力		P _D	—	320	450	mW	—
全転送効率		TTE	92	98	—	%	—
出力インピーダンス		Z _O	—	60	250	Ω	—
信号出力直流電圧		V _{OS}	4.0	5.25	6.0	V	(注 9)
リセットノイズ		V _{RSN}	—	0.75	—	V	
ランダムノイズ		N _{Dσ}	—	2.2	—	mV	(注 10)

電気・光学的特性 (1200 dpi, ロー・ゲインモード)

$T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{OD} = 10\text{ V}$, $V_{\phi} = V_{SH} = V_{RS} = V_{CP} = 3.3\text{ V}$ (パルス), $f_{\phi} = 2.5\text{ MHz}$, $f_{RS} = 5.0\text{ MHz}$,
 $t_{INT} = 11\text{ ms}$, 光源 = A 光源 + CM500S ($t = 1.0\text{ mm}$)

項 目		記 号	最小	標準	最大	単位	備考
感度	赤色	R _R	9.7	13.9	18.1	V/(lx·s)	(注 2)
	緑色	R _G	10.6	15.2	19.8		
	青色	R _B	5.6	8.1	10.6		
感度不均一性		PRNU (1)	—	10	20	%	(注 3)
		PRNU (3)	—	3	12	mV	(注 4)
レジスタインバランス		RI	—	1	—	%	(注 5)
飽和出力電圧		V _{SAT}	1.9	2.1	—	V	(注 6)
飽和露光量		SE	0.09	0.13	—	lx·s	(注 7)
暗時出力電圧		V _{DRK}	—	0.2	2.0	mV	(注 8)
暗時出力不均一性		DSNU	—	2.0	10.0	mV	
直流消費電力		P _D	—	320	450	mW	—
全転送効率		TTE	92	98	—	%	—
出力インピーダンス		Z _O	—	60	250	Ω	—
信号出力直流電圧		V _{OS}	4.0	5.25	6.0	V	(注 9)
リセットノイズ		V _{RSN}	—	0.5	—	V	
ランダムノイズ		N _{Dσ}	—	1.6	—	mV	(注 10)

注 2: 感度は感光面に照度および色温度が一様な光をあてたときの各色の全有効画素平均出力値とします。

注 3: PRNU (1) は感光面に照度および色温度が一様な光をあてたときに各色ごとに次式にて定義します。
なお、入射光量は全有効画素の平均出力を約 1000 mV に設定します。

$$\text{PRNU}(1) = \frac{\Delta X}{\bar{X}} \times 100 (\%)$$

ただし、 $\bar{X}$: 同一色における全有効画素の平均出力振幅値

ΔX : 最大 (最小) 出力画素の出力振幅と $\bar{X}$ との差の絶対値を ΔX とします。

注 4: PRNU (3) は同一色における全有効画素の平均信号出力量が約 50 mV となる光量を入射したときの隣接画素の出力電圧差の最大値とします。

注 5: レジスタインバランスは次式にて定義します。

$$\text{RI} = \frac{\sum_{n=1}^{10679} |X_n - X_{(n+1)}|}{10679 \times \bar{X}} \times 100 (\%)$$

注 6: VSAT は全有効画素の飽和出力電圧の最小値で定義します。

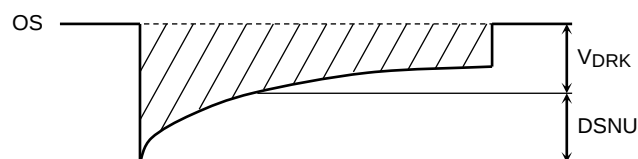
条件は過飽和露光量で VOD は 9.5 V です。

注 7: 飽和露光量は次式にて定義します。

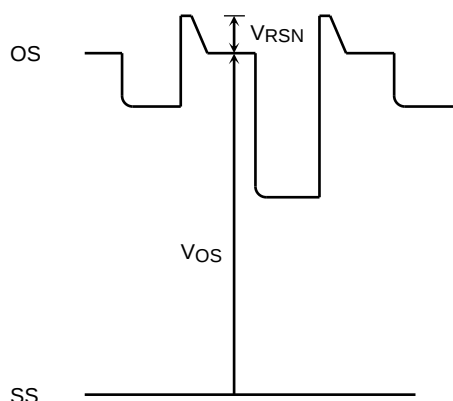
$$\text{SE} = \frac{\text{VSAT}}{\text{RG}}$$

注 8: VDRK は全有効画素の暗時出力電圧の平均値で定義します。

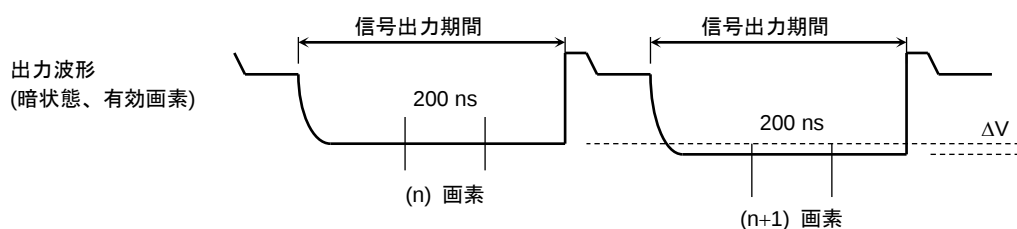
DSNU は全有効画素の暗時出力電圧の最大値と平均値との差で定義します。



注 9: 信号出力直流電圧、リセットノイズとは、下記の電圧値のことです。



注 10: ランダムノイズは暗状態での隣接する有効画素 2 ビット間の出力レベル差の標準偏差値にて定義します。



- (1) 1 ライン内の隣接する有効画素 2 ビット ((n) 画素、(n + 1) 画素) を測定点と定めます。
- (2) 両画素の出力レベルを信号出力期間内の 200ns で平均化し、 $V(n)$ と $V(n + 1)$ を求めます。
- (3) $V(n)$ から $V(n + 1)$ を減じ、 ΔV を求めます。

$$\Delta V = V(n) - V(n+1)$$

- (4) 上記 (2), (3) を 30 回繰り返し、 ΔV の標準偏差 σ を求めます。

$$\overline{\Delta V} = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} |\Delta V_i| \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} (|\Delta V_i| - \overline{\Delta V})^2}$$

- (5) 上記 (2), (3), (4) を 10 回繰り返し、 ΔV の標準偏差 σ を平均します

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{10} \sum_{j=1}^{10} \sigma_j$$

- (6) この $\bar{\sigma}$ は、グラウンドレベルを基準に観測される 1 画素のランダムノイズの標準偏差に比べて $\sqrt{2}$ 倍大きい値になります。従って、ランダムノイズを以下のとおり定義します。

$$ND\sigma = \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{\sigma}$$

なお、ここで定義したランダムノイズを記号で “NDσ” と定めます。

推奨端子電圧(Ta = 25 °C)

本製品の性能を十分に発揮するための条件です。推奨動作条件の範囲内でお使いください。

項 目		記 号	最小	標準	最大	単位
転送パルス電圧	“H”レベル	V _{φ1A}	3.1	3.3	5.5	V
	“L”レベル	V _{φ2A}	0	0	0.1	
最終段転送パルス電圧	“H”レベル	V _{φ1B}	3.1	3.3	5.5	V
	“L”レベル	V _{φC}	0	0	0.1	
シフトパルス電圧	“H”レベル	V _{SH}	3.1	3.3	5.5	V
	“L”レベル		0	0	0.1	
スイッチパルス電圧	“H”レベル	V _{SW}	3.1	3.3	5.5	V
	“L”レベル		0	0	0.1	
リセットパルス電圧	“H”レベル	V _{RS}	3.1	3.3	5.5	V
	“L”レベル		0	0	0.1	
クランプパルス電圧	“H”レベル	V _{CP}	3.1	3.3	5.5	V
	“L”レベル		0	0	0.1	
電源電圧		V _{OD}	9.5	10.0	10.5	V

クロック特性(Ta = 25 °C)

本製品の性能を十分に発揮するための条件です。推奨動作条件の範囲内でお使いください。

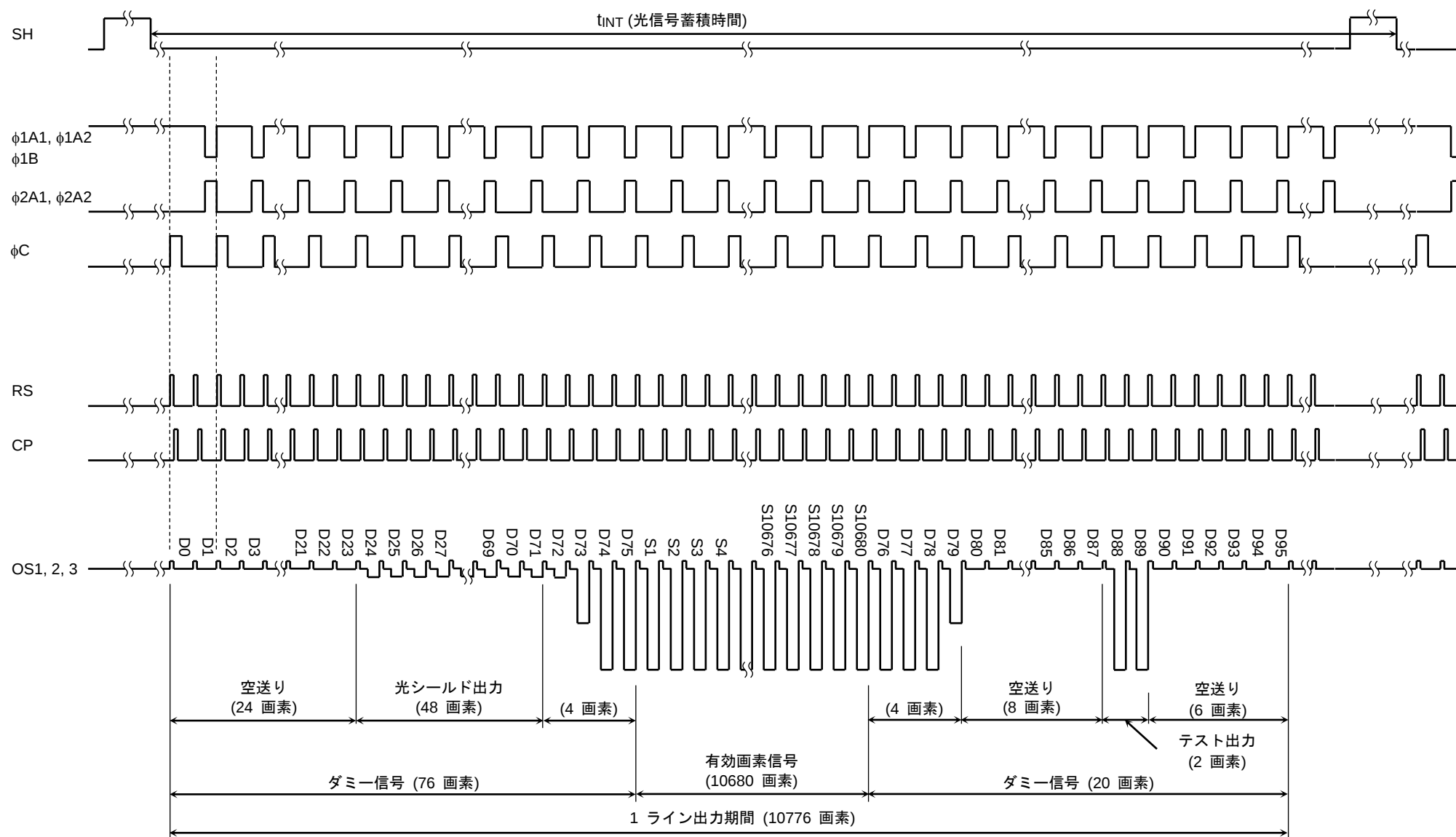
項 目		記 号	最小	標準	最大	単位
クロックパルス周波数		f _φ	2.5	2.5	35.0	MHz
リセットパルス周波数		f _{RS}	5.0	5.0	35.0	MHz
クランプパルス周波数		f _{CP}	5.0	5.0	35.0	MHz
クロック(1A) 入力端子容量	(注 11)	C _{φ1A}	—	95	—	pF
クロック(2A) 入力端子容量	(注 11)	C _{φ2A}	—	100	—	pF
最終段クロック入力端子容量	(注 11)	C _{φ1B} , C _{φC}	—	7	—	pF
シフトゲート入力端子容量		C _{SH}	—	16	—	pF
スイッチゲート入力端子容量		C _{SW}	—	16	—	pF
リセットゲート入力端子容量		C _{RS}	—	7	—	pF
クランプゲート入力端子容量		C _{CP}	—	7	—	pF

注 11: V_{OD} = 10 V 印加時の 1 端子当たりの端子容量とします。

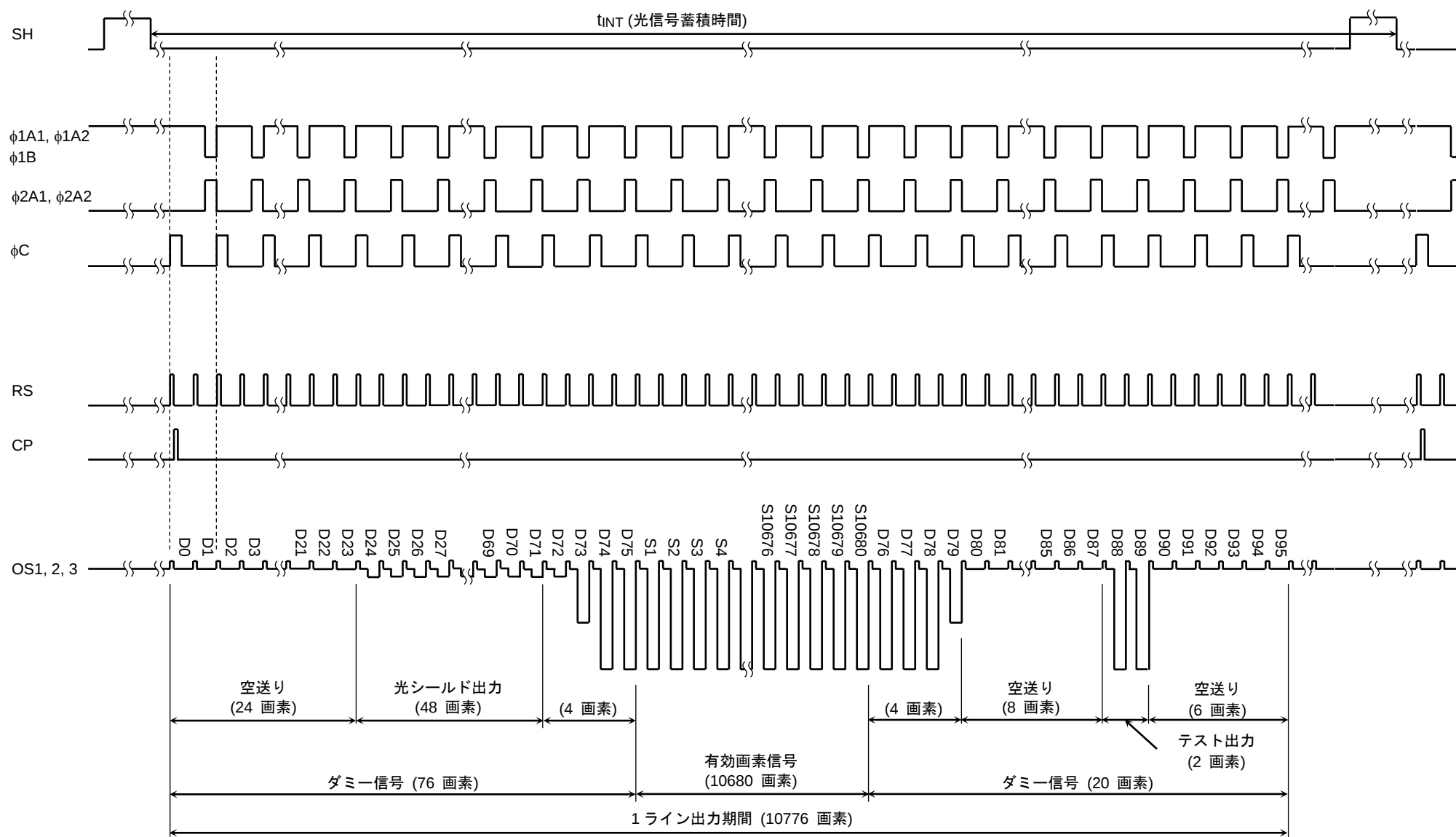
モード選択

モード			SH	$\phi 1A, \phi 2A$	$\phi 1B$	ϕC	RS	CP	SW
ビット クランプ	ハイ・ ゲイン	1200 dpi	Pulse	Pulse	$\phi 1A$	Pulse	Pulse	Pulse	“L”
		600 dpi			$\phi 1A$				
/ ライン クランプ	ロー・ ゲイン	1200 dpi	Pulse	Pulse	$\phi 1A$	Pulse	Pulse	Pulse	“H”
		600 dpi			$\phi 1A$				

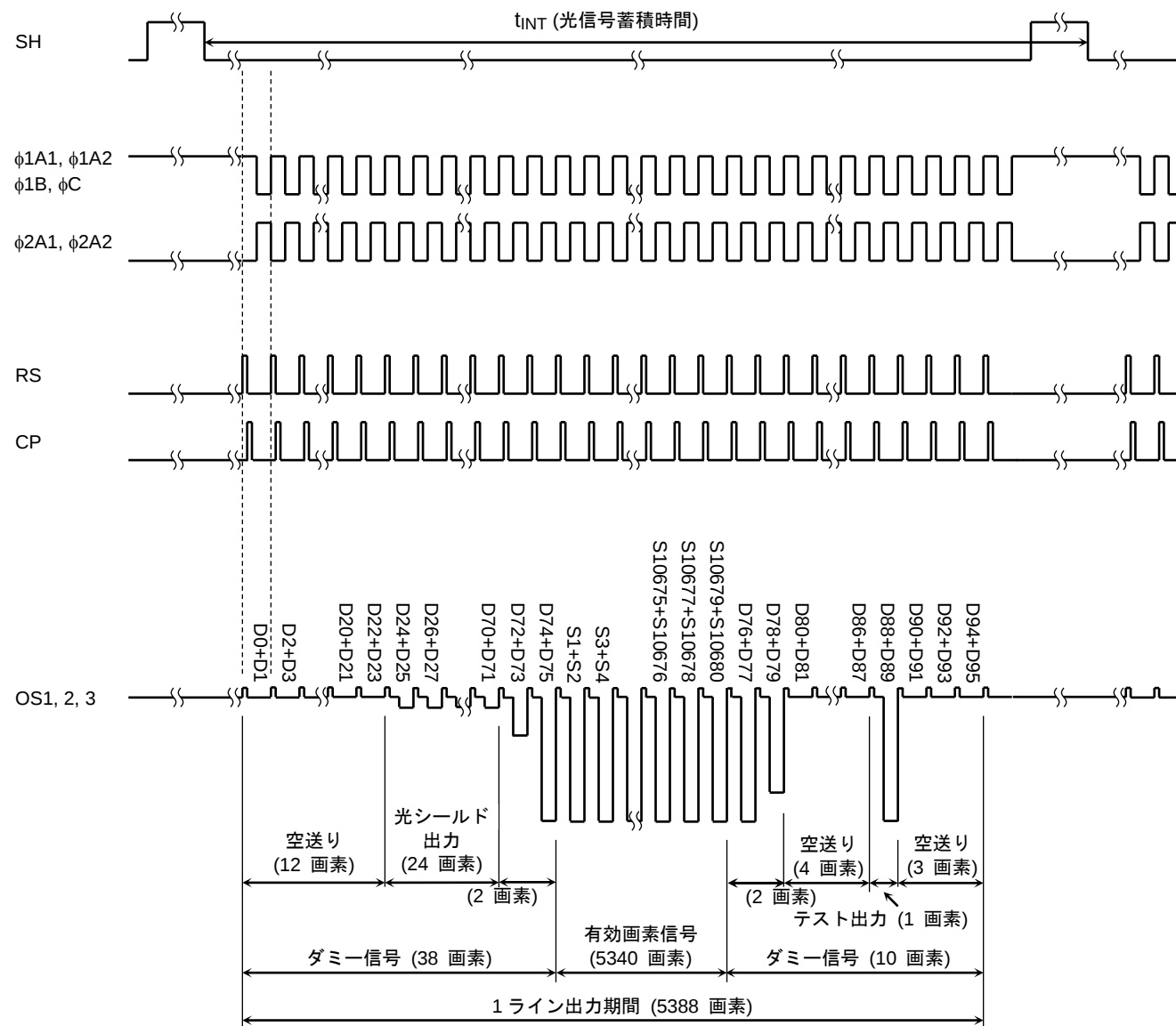
タイミング図 1: 1200 dpi モード (ビットクランプモード)



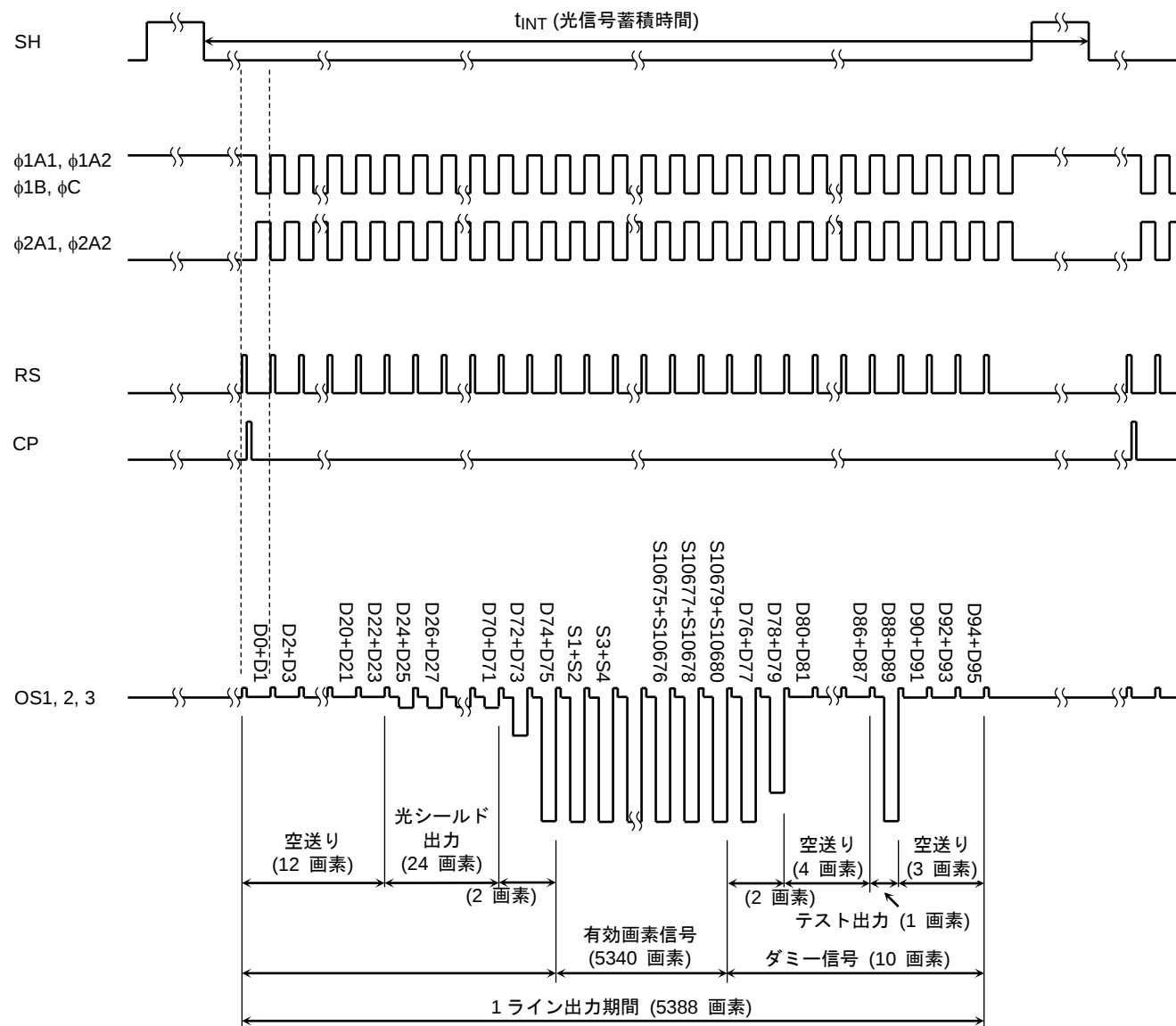
タイミング図 2: 1200 dpi モード (ラインランプモード)



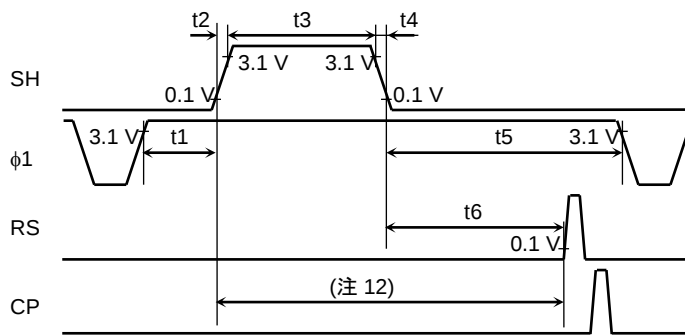
タイミング図 3: 600 dpi モード (ビットクランプモード)



タイミング図 4: 600 dpi モード (ラインランプモード)

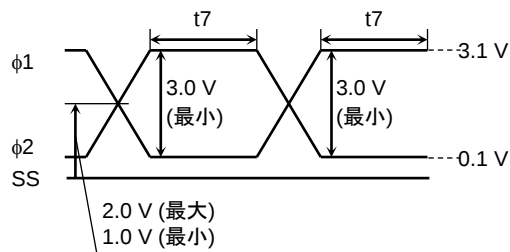


パルス波形条件

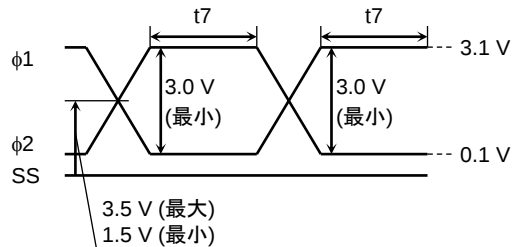


注 12: この期間は RS、CP の各端子を”L” レベルとしてください。

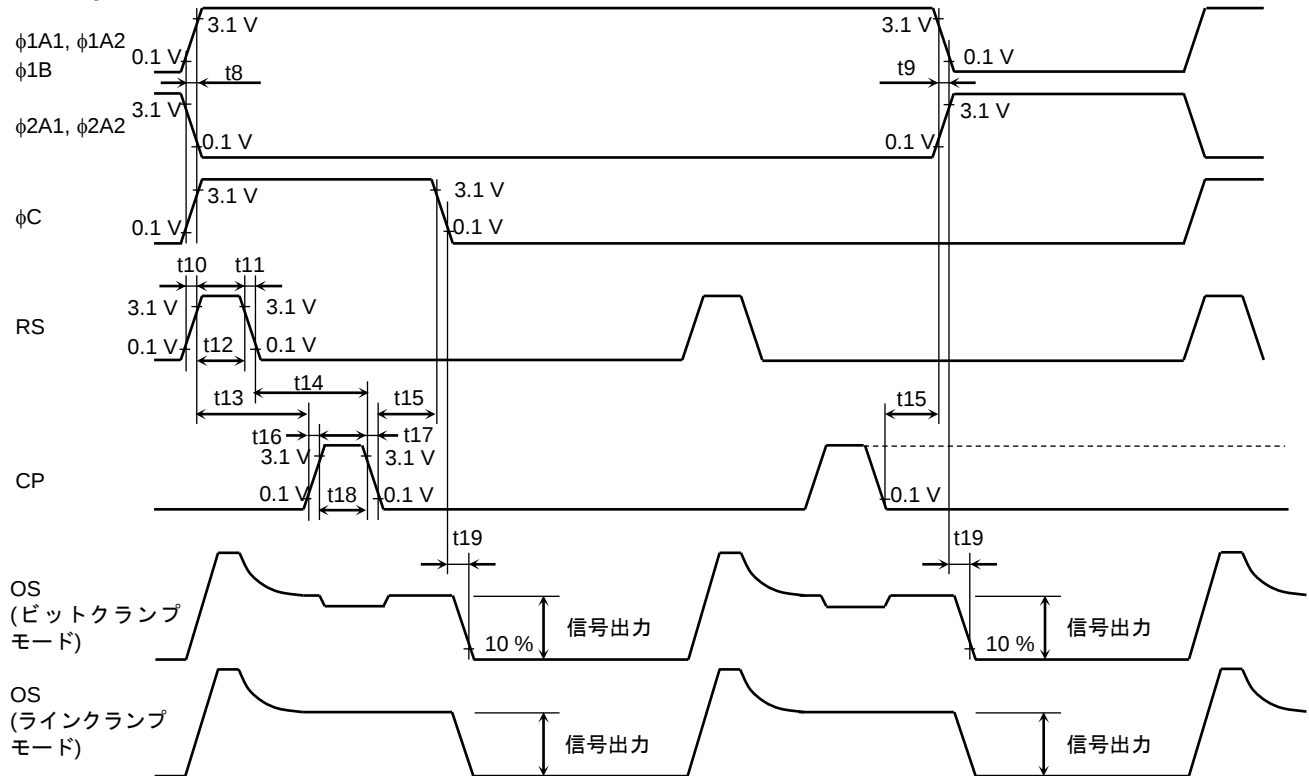
クロスポイント条件 (転送パルス電圧 3.3 V)



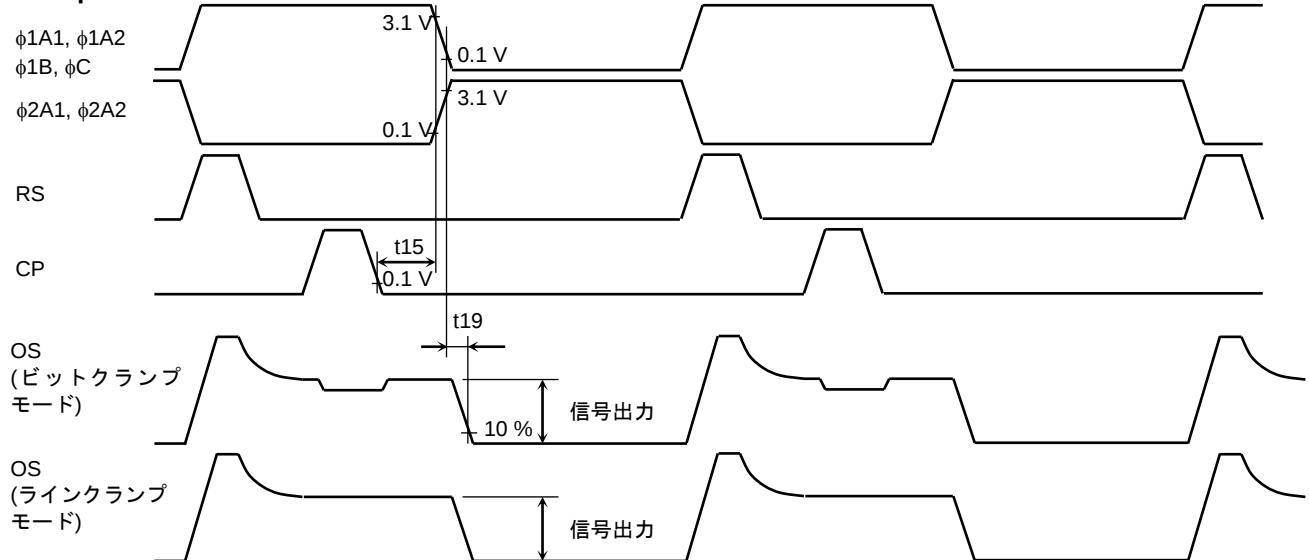
クロスポイント条件 (転送パルス電圧 5.0 V)



1200 dpi モード



600 dpi モード



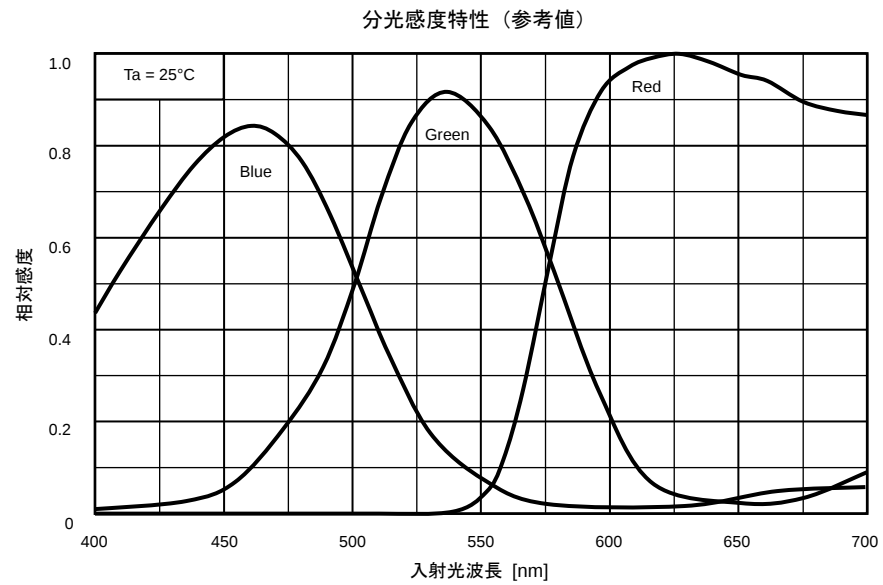
項 目	記 号	最小	標準 (注 13)	最大	単位
SH、 $\phi 1$ パルスタイミング	t1	120	200	2500	ns
	t5	1000	1075	2500	ns
SH パルス立ち上がり、立ち下がり時間	t2, t4	0	10	—	ns
SH パルス期間	t3	3000	3500	—	ns
SH、RS パルスタイミング	t6	500	—	—	ns
$\phi 1A1$, $\phi 1A2$, $\phi 2A1$, $\phi 2A2$ パルス期間 (注 14)	t7	10	90	—	ns
$\phi 1A1$, $\phi 1A2$, $\phi 2A1$, $\phi 2A2$ パルス立ち上がり、立ち下がり時間	t8, t9	0	15	—	ns
RS パルス立ち上がり、立ち下がり時間	t10, t11	0	10	—	ns
RS パルス期間	t12	8	15	—	ns
RS、CP パルスタイミング	t13	0	0	—	ns
	t14	8	50	—	ns
$\phi 1B$ 、CP パルスタイミング	t15	0	40	—	ns
ϕC 、CP パルスタイミング					
CP パルス立ち上がり、立ち下がり時間	t16, t17	0	10	—	ns
CP パルス期間	t18	8	40	—	ns
信号出力遅延時間	t19	—	8	—	ns

注 13: 標準は $f_{RS} = 5 \text{ MHz}$ です。

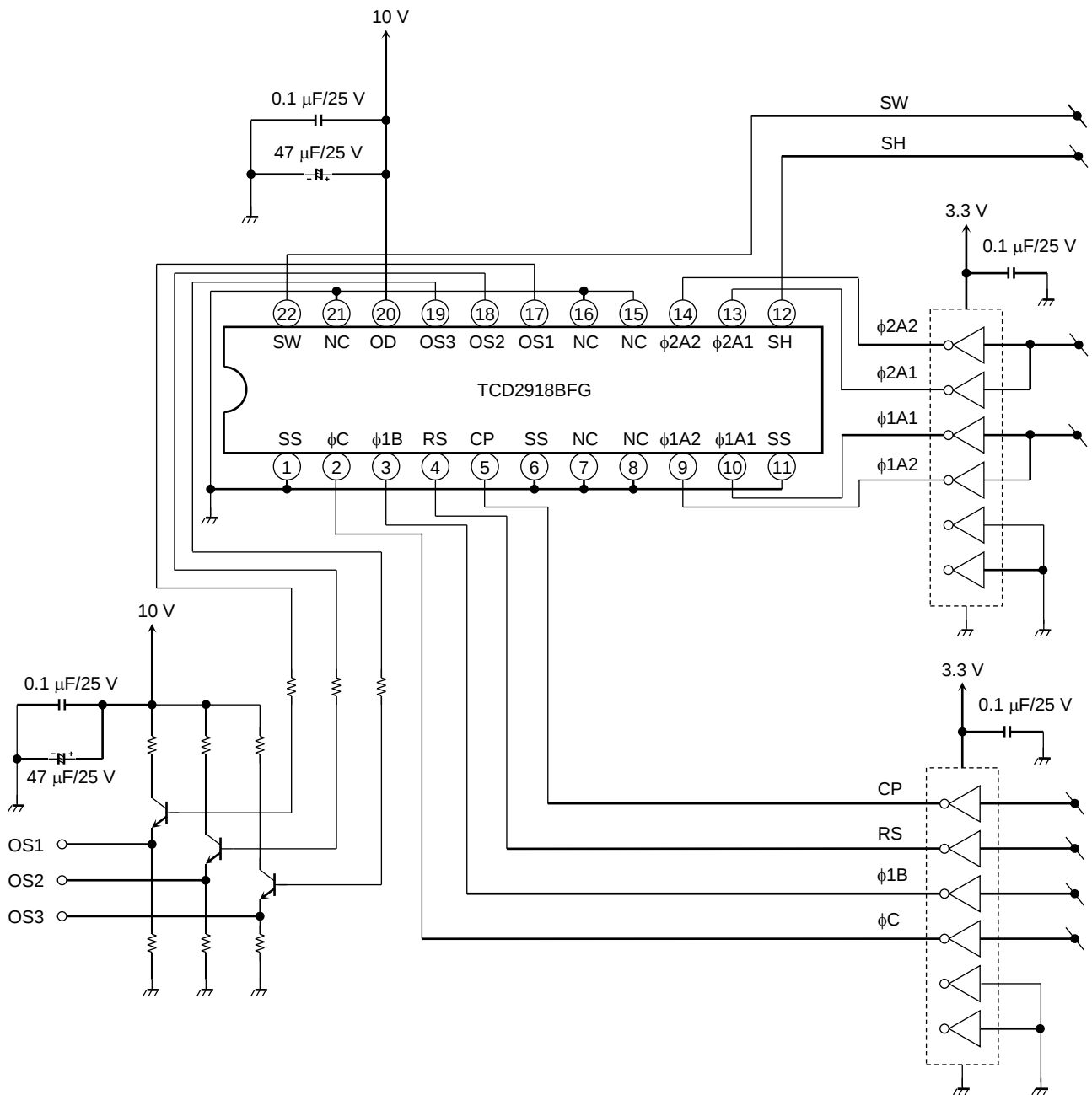
注 14: $\phi 1$ と $\phi 2$ の電圧差が 3.0 V 以上になる時間をパルス期間と定義します。

この規格は転送効率に影響するのでご注意ください。

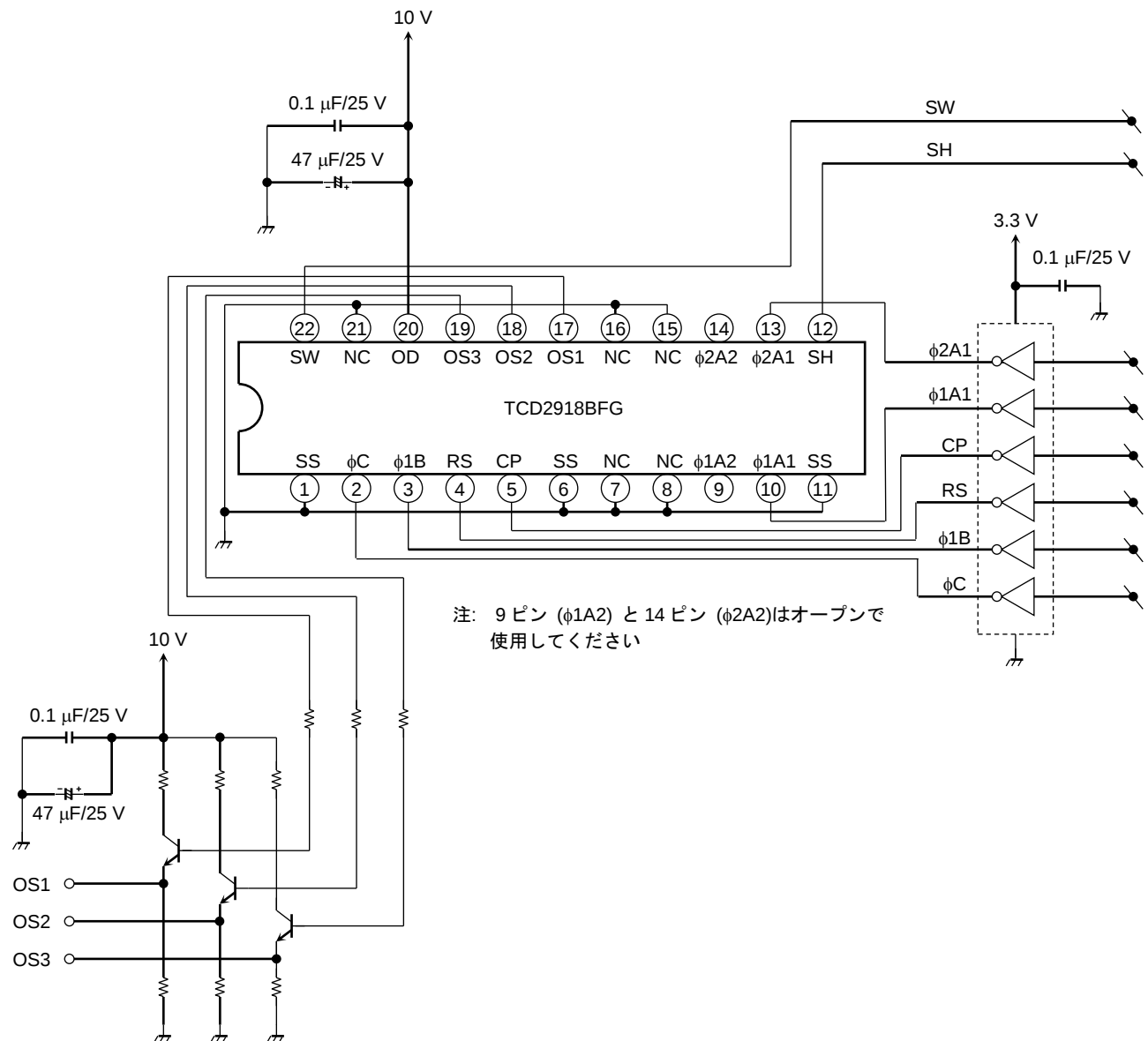
分光感度特性（参考値）



周辺回路例 (高速動作)



周辺回路例 (低速動作)



CCD イメージセンサ使用上の注意

1. 静電気対策

CCD イメージセンサには静電気に対する保護がなされていますが、静電気による破壊モード不良とみられるデバイスが発見される場合があります。デバイスの取り扱いに際しては静電気による製造システムの故障率増加を未然に防ぐために、次に掲げるような静電気防止対策を実施する必要があります。

- a. 作業は素手または非常電性の手袋を着用し、作業着なども非常電性のものを使用してください。また、靴は導電靴を使用してください。
- b. 作業場などの床、扉、台などはアース板、またはアース線を設け、静電気を放電してください。
- c. はんだごて、ラジオペンチ、ピンセットなどの工具はアースしてください。
- d. 直接ハンドリングする場合は、アースバンドを使用してください。
- e. CCD イメージセンサを取り扱う際には、イオナイズド・エアで除電することを推奨します。

静電気に関する注意事項は必ずしも全部実施する必要はなく、故障率が規定範囲内にあることを確認しつつ緩和することが肝要です。

2. 入力光について

CCD イメージセンサは光波長の広範囲帯域に感度を持っていますが、可視光領域外の長波長入力光で使用した際には諸特性に大きな変化が生じる場合があります。

また、強い光に長時間さらさないようにしてください。カラーイメージセンサの場合、長時間強い光を当てると色フィルタが退色することがあります。

3. ガラス内面曇り

CCD 面実装品は吸湿した状態で実装時の熱ストレスを受けますと、ガラス内面の水分付着による曇りが発生する可能性がありますので、下記に注意してください。

なお、ガラス内面に曇りが生じても、画素領域にかからない場合は品質上問題ありません。

製品は、アルミ袋開封前は 30 °C・90 %RH 以下の環境で保管し、アルミ袋開封後は 30 °C・60 %RH 以下の環境で保管してください。

シール日より 12 カ月以内、かつアルミ袋開封後 6 カ月以内に実装してください。(シール日はアルミ袋に印刷されます)

4. 超音波洗浄

CCD イメージセンサのような気密封止タイプのデバイスは、超音波洗浄を行うと接続ワイヤが共振して断線する恐れがありますので、超音波洗浄は避けてください。

5. 実装

はんだ実装の際には、ウインドウガラスの表面にリフロー炉内のゴミや汚れが付着しないように、あらかじめ付いているウインドウガラス保護テープを付けた状態で実装してください。

6. ウインドウガラス保護テープ

ウインドウガラス保護テープは、静電気が帯電しやすい材料を使用しています。はんだ実装後、テープを剥がす際にはイオナイズド・エアを使用し、テープに帯電しないようにしてください。

ウインドウガラス保護テープを剥がす際にガラス表面に接着剤が残ります。この接着剤は画像に黒傷もしくは白傷として現れますので、有機溶剤などを含ませた布などでガラス表面の接着剤をふき取ってください。

テープの再利用はしないでください。

7. はんだ付け温度プロファイル

各実装方法における推奨実装温度プロファイルは次のとおりです。なお、デバイス取り外しを伴う修繕作業に関しては、はんだ取り残しにより平行度が損なわれる可能性があるため行わないでください。また、デバイス取り外しを伴わない修繕作業に関しては、はんだごてで行う、またはリフローの場合は1回で実施してください。

はんだごての場合

電極部温度を 350 °C、3 秒以内で実施してください。

遠赤外線リフロー/温風リフローの場合

下記条件の範囲で、パッケージ表面(電極)温度が、各はんだメーカーの推奨プロファイルとなる条件でリフローしてください。

ピーク温度	: 250 °C 以下
保持	: 220 ~ 250 °C、30 ~ 40 秒
プレヒート	: 150 ~ 190 °C、60 ~ 120 秒

8. ウィンドウガラス

ウィンドウガラスの表面にゴミや汚れが付着していると、画像に黒キズとして現れますので、使用する際は必ずウィンドウガラス表面を清掃してください (例えば、アルコールなどの有機溶液を少量含ませた柔らかい布または紙などでゴミ、汚れをふき取ってください)。

また、デバイスを落下させたりウィンドウガラス表面に強い摩擦を与えますと、ウィンドウガラスが破損したり傷が付く恐れがありますので、デバイスの取り扱いには十分注意してください。

9. ウィンドウガラス表面のクリーニング方法

ふき取りクロス

- 目が細かい柔らかい布を使用してください。
- ふき取りクロスはそれ自体から発塵しないものを使用してください。
- ふき取りクロスは必ず清潔なものを使用してください。

クリーナー

アルコールなどの他の溶剤を使用する場合は次に注意してください。

- 速乾性で清浄なもの。
- 液が乾燥した後、残渣がないこと。
- 人体に安全なもの。

また、溶剤の使用期限を守り、溶剤の保管容器も清潔なものを使用してください。
火気には十分注意してください。

クリーニング方法

最初に、クリーナーをしみこませたふき取りクロスでウィンドウガラスの表面をふきます。最低2回以上ふいでください。

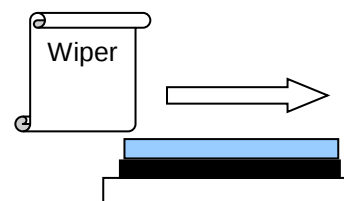
次に、乾いたふき取りクロスで乾ぶきしてください。最低3回以上ふいでください。

最後に、フィルタリングされた乾いた N₂ によりブロー洗浄して下さい。

上述の工程でクリーニングして汚れが残っている場合は、最初から繰り返してください。

ふき取りの際には次の点に注意してください。

- クリーナーは付け過ぎないでください。
- ふき取り部分は光学範囲内とし、ウィンドウガラスの縁には触らないようにしてください。
- 必ず長辺方向に同一方向でふいでください。
- ふき取りクロスは常に未使用部分を使用してください。



10. 実装基板のフットパターンについて

実装基板のフットパターンとして、図1のものを推奨します。

单位: mm

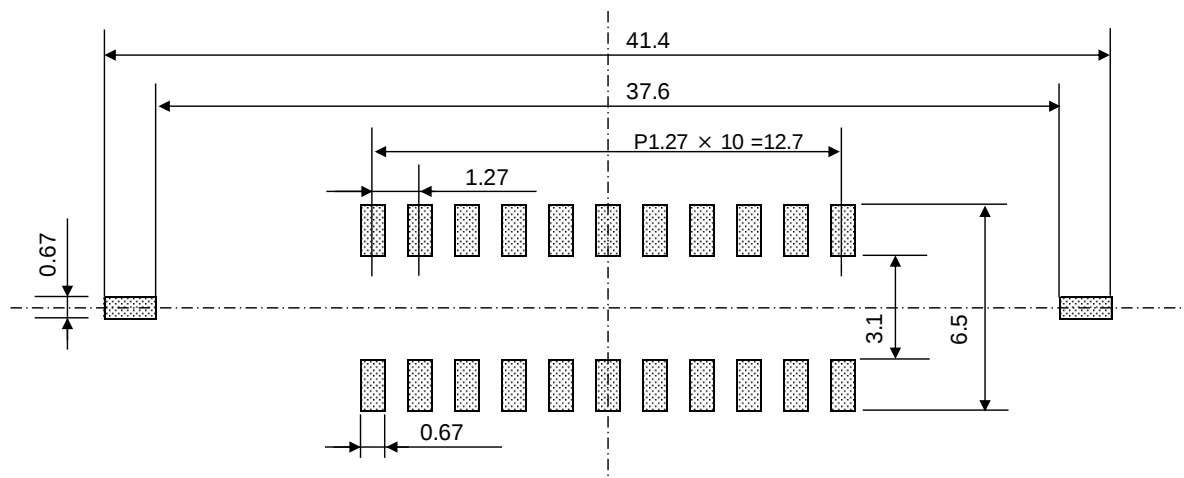


图 1

11. はんだペーストの塗布のメタルマスクについて

実装基板にはんだペーストを塗布する際、下記の厚さのメタルマスクを推奨します。

- ・メタルマスク厚：0.2 mm

また、メタルマスクの開口サイズは、図 1 で示す推奨フットパターンの 95 ~ 100 % を推奨します。

12. 温度サイクルについて

CCD 面実装製品は、実装後、過度に温度サイクルストレスがかかると、はんだ部にクラックが生じる恐れがあります。はんだクラックを防止する方法として、アンダーフィルが有効です。

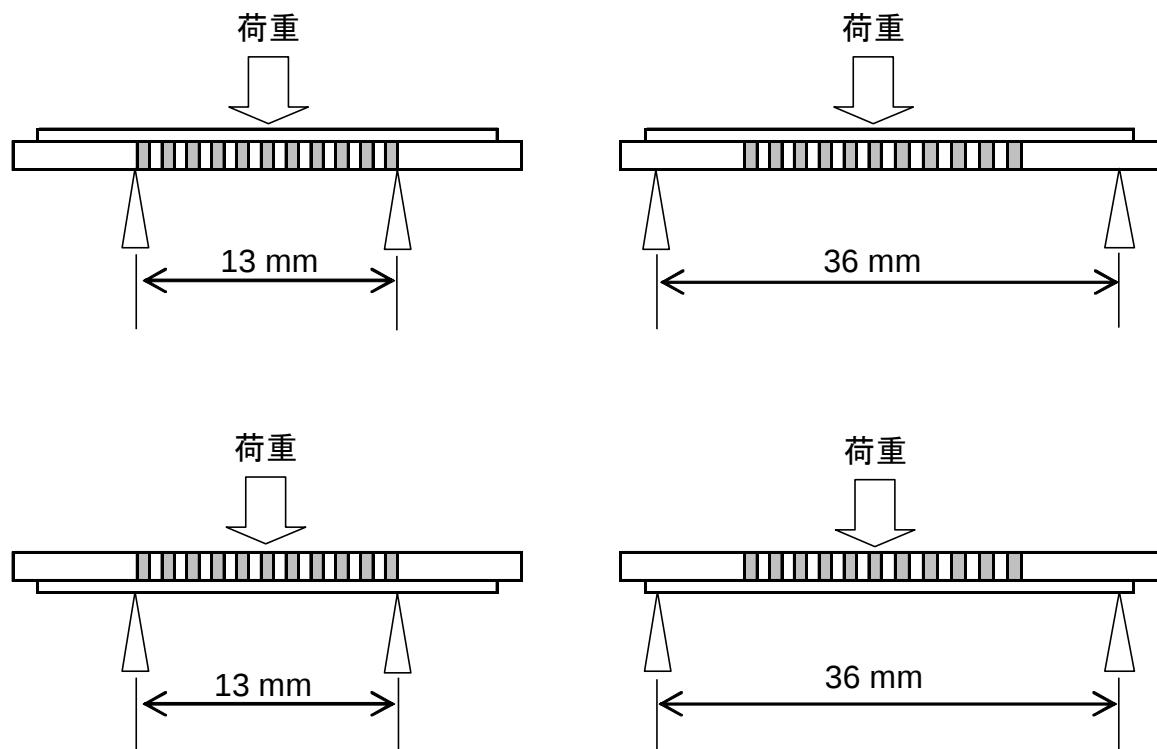
13. 自傷について

イメージセンサは、時間の経過とともに宇宙線に起因した白傷が発生する場合があります

14. パッケージ取り扱い上の注意

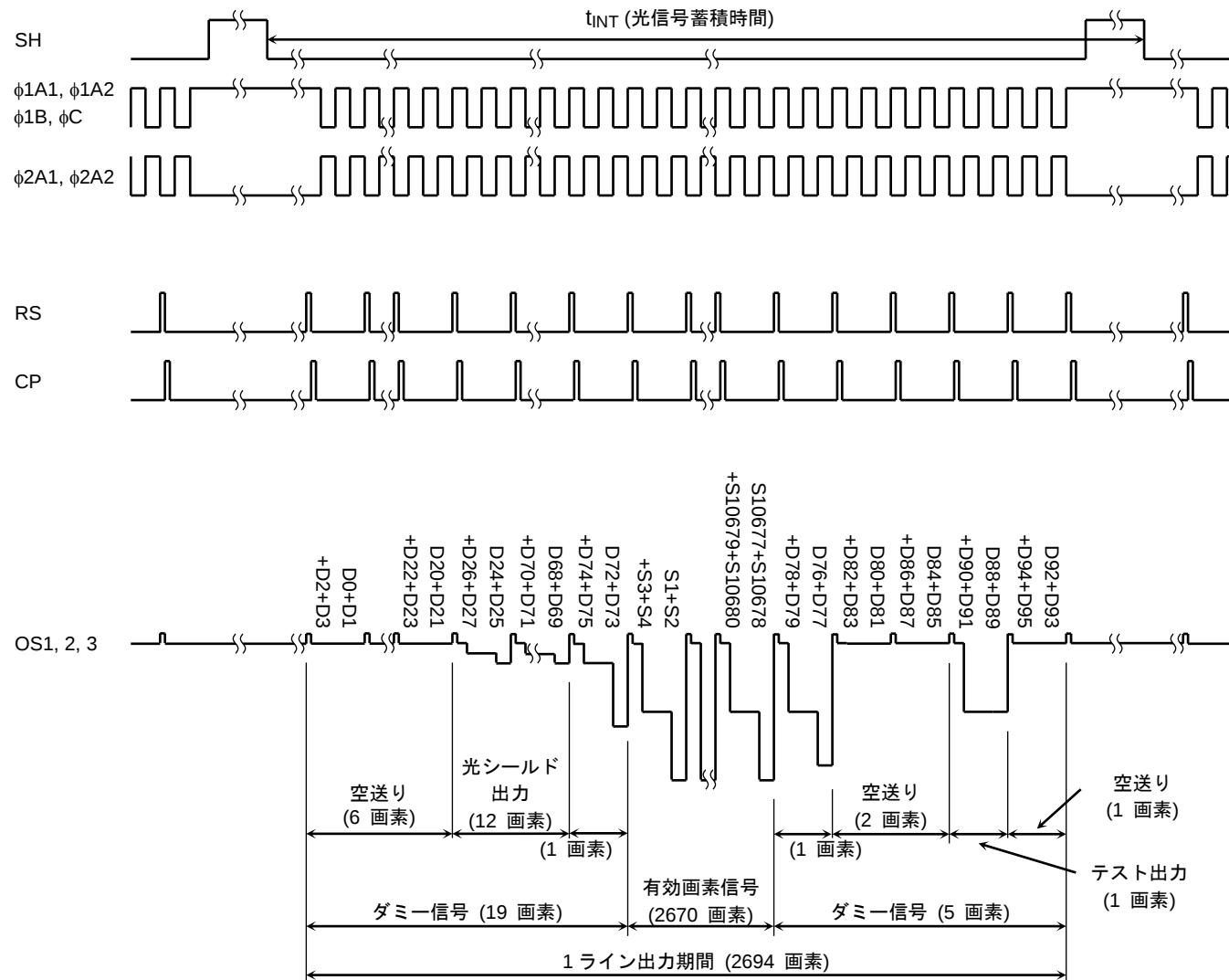
パッケージに過度の荷重が加わった場合、パッケージの破断や内部チップの剥離が発生する恐れがあります。本製品の3点曲げ強度の参考値は以下のとおりで、荷重が支持点から遠くなるほどパッケージに加わるストレスが増します。基板への実装後も、基板の個片化作業、ガラス表面のふき取り作業、光学部品への取り付け作業など、パッケージに荷重が加わり得る作業では、特に取り扱いにご注意ください。

3点曲げ強度試験方法

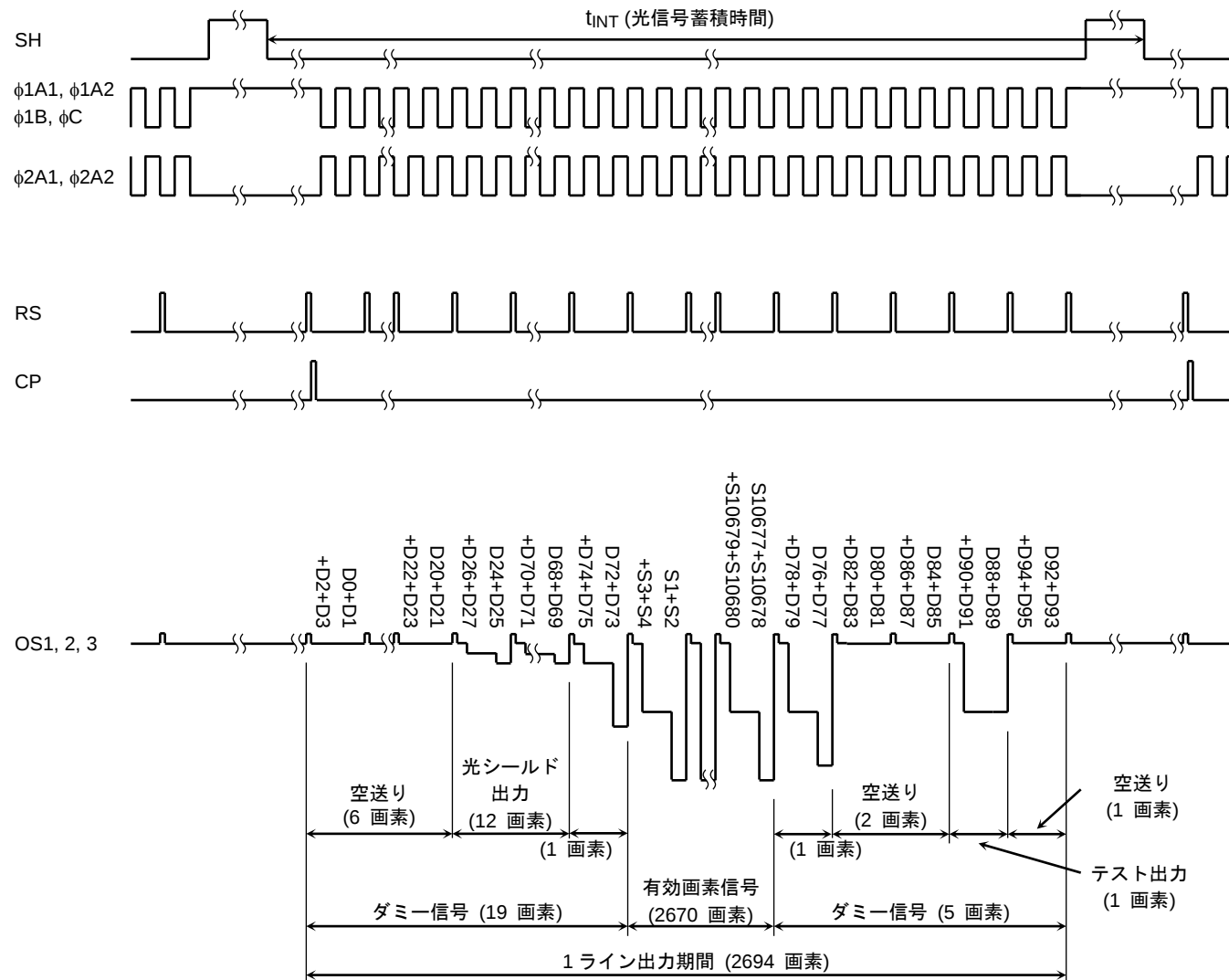


- ・ 22 pin CLCC
 - 支点スパン 13 mm : ガラス方向からの荷重 : 300 [N]
 - 裏方向からの荷重 : 200 [N]
 - 支点スパン 36 mm : ガラス方向からの荷重 : 150 [N]
 - 裏方向からの荷重 : 80 [N]

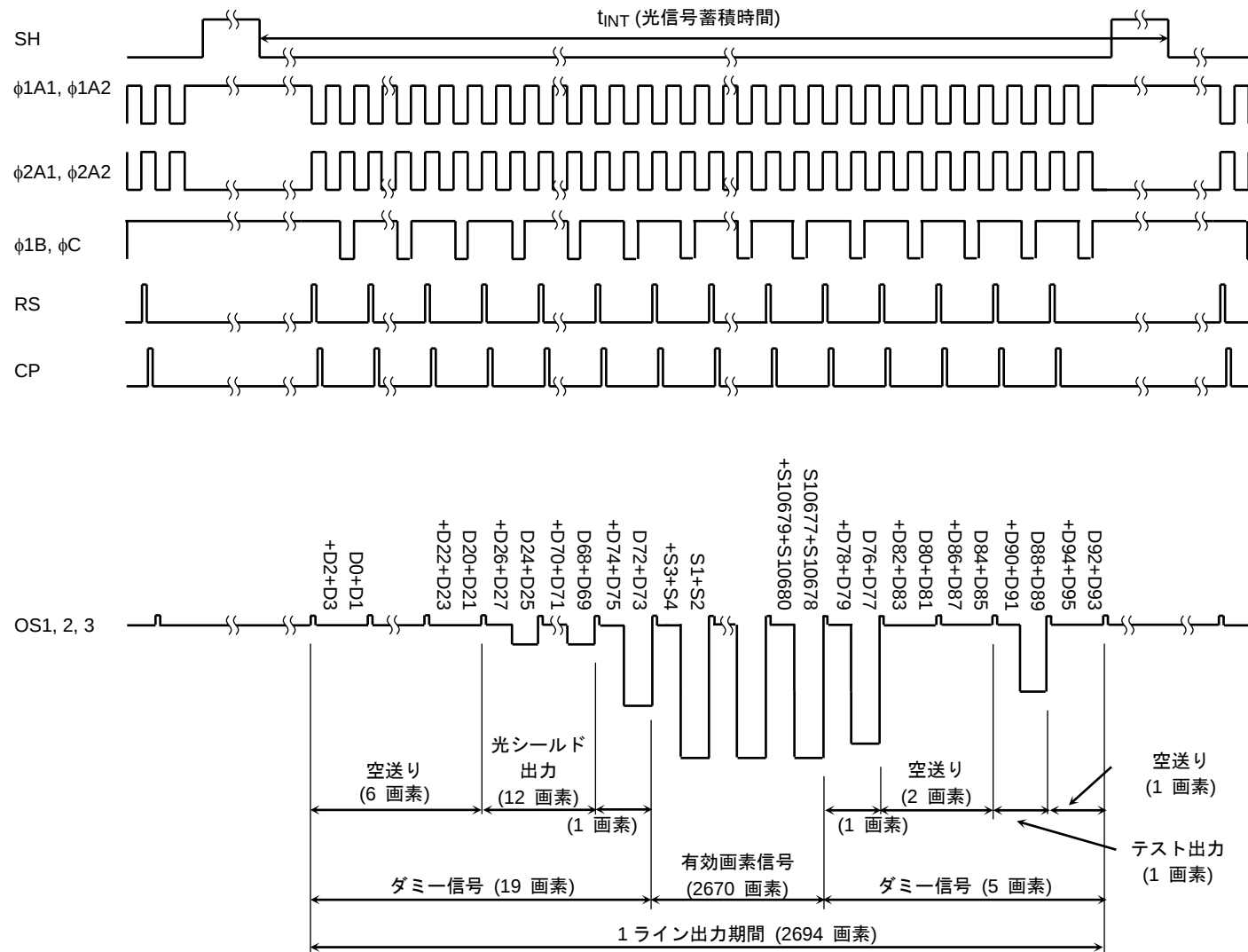
アプリケーションノート (参考): タイミング図 (300 dpi ビットクランプモード)



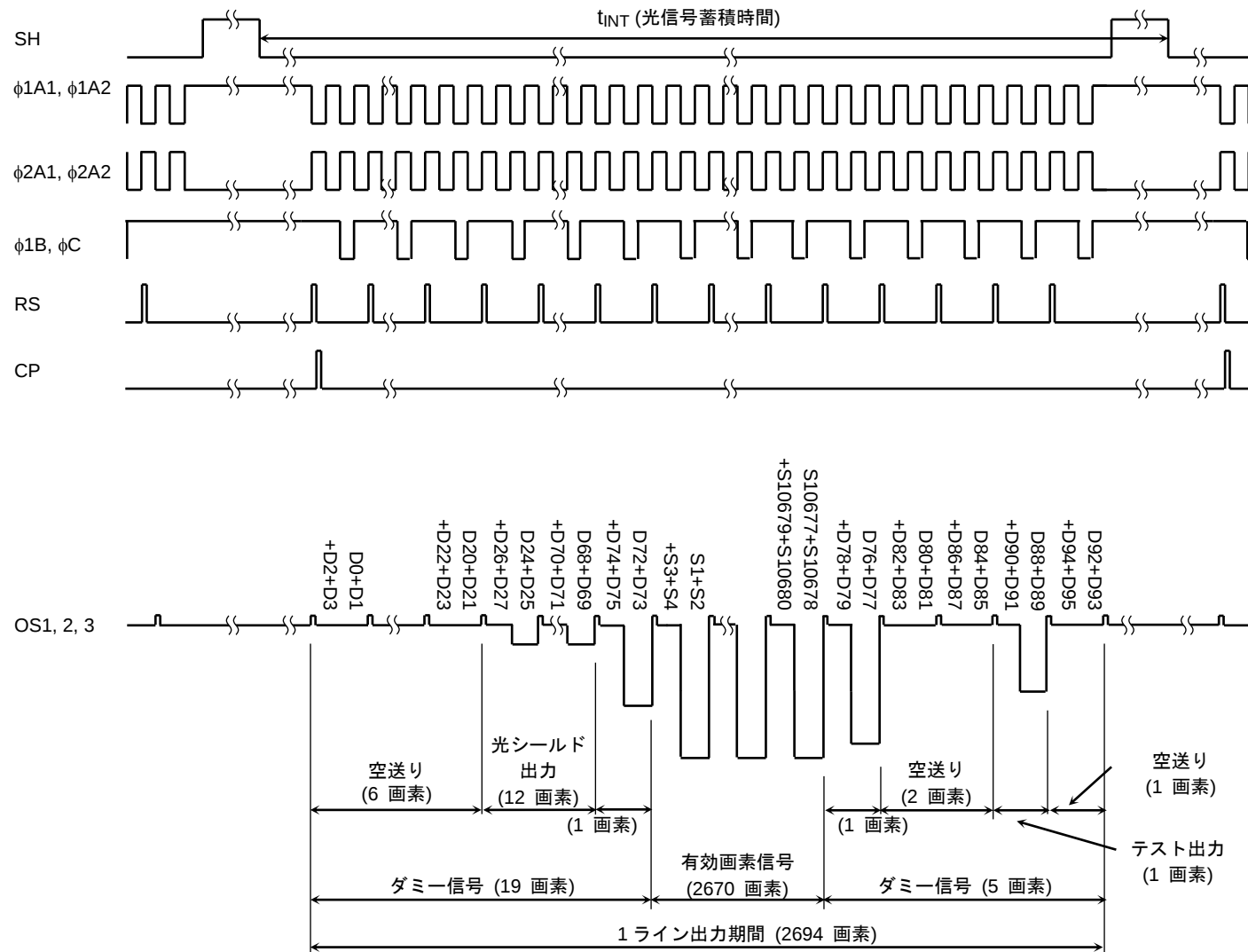
アプリケーションノート(参考): タイミング図 (300 dpi ラインランプモード)



アプリケーションノート (参考): タイミング図 (300 dpi ビットクランプモード) 信号期間拡大タイミング

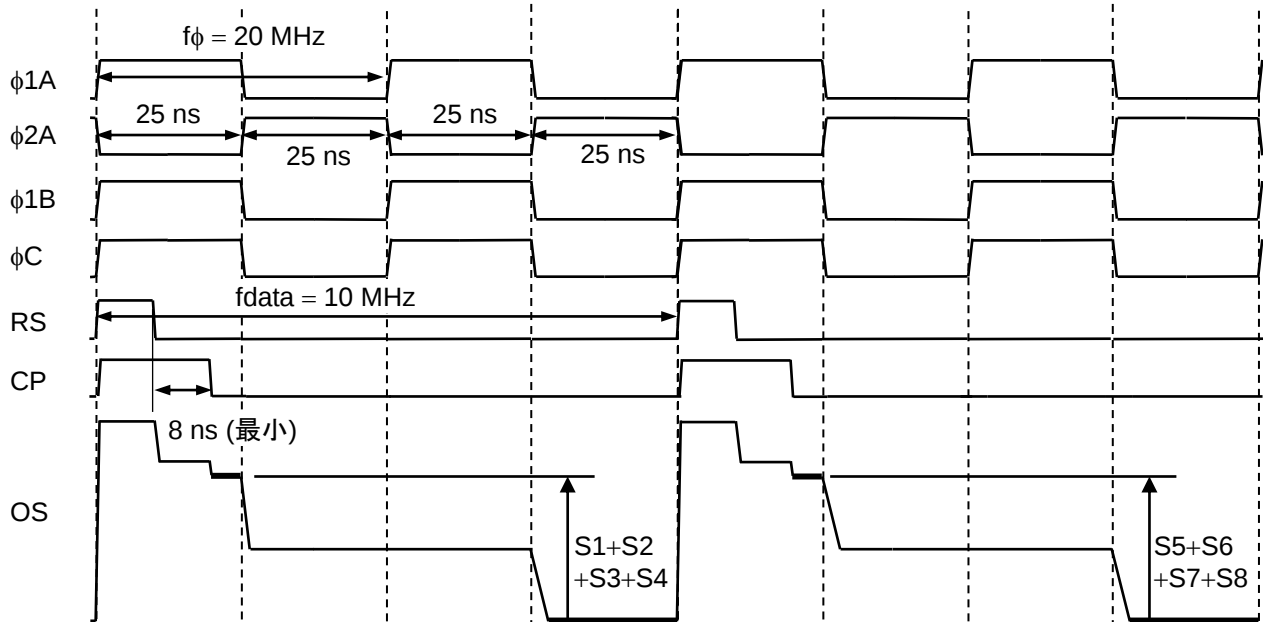


アプリケーションノート (参考): タイミング図 (300 dpi ラインランプモード) 信号期間拡大タイミング

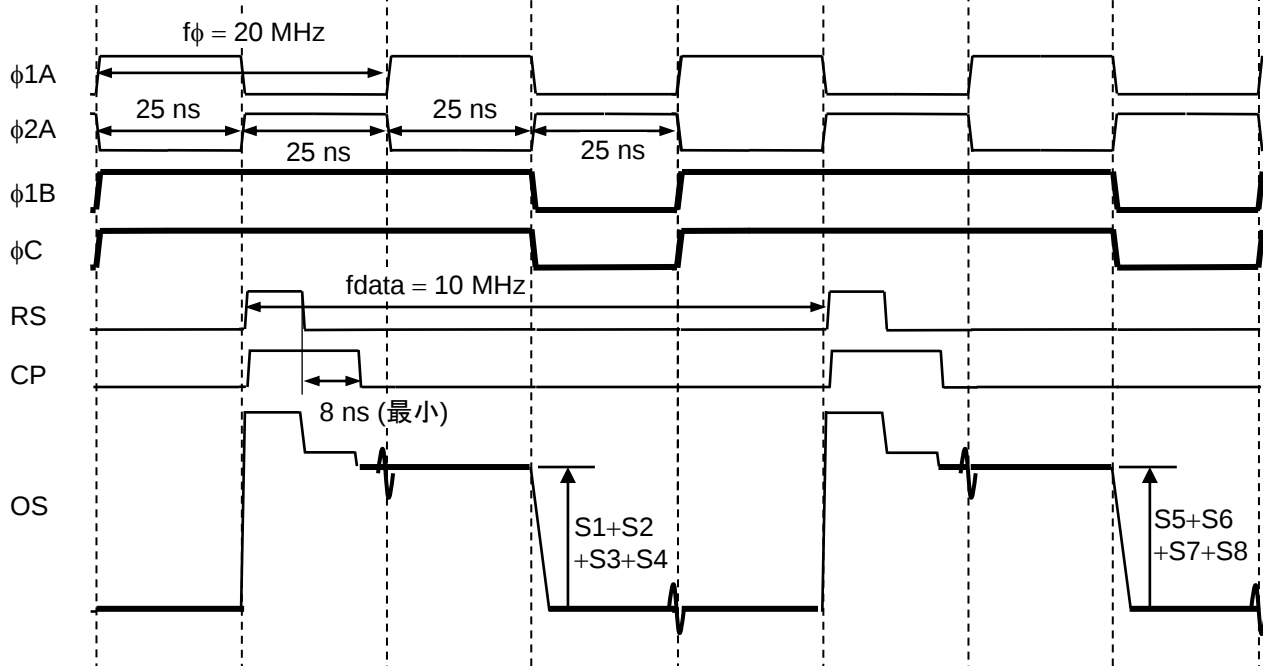


タイミング波形例 (300 dpi モード / $f_{\phi} = 20 \text{ MHz}$ / $f_{\text{data}} = 10 \text{ MHz}$)

標準タイミング



信号期間拡大タイミング



單位：mm



製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

東芝デバイス&ストレージ株式会社

<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/>